

银灿科技发表 USB 3.0 双通道超高效能解决方案

发布: 2010-10-14 09:23 | 作者: [——](#) | 来源: 华强电子网 |

TAG: [USB](#) [银灿科技](#)



据银灿科技表示,目前由于 PC 及 笔记型计算机已大量内建 USB 3.0 且 Intel 及 AMD 都将南桥的 Reference Design 提前于 2010 年放入 USB 3.0 的解决方案,可预见今年将是 USB 3.0 元年。

对于 USB 3.0 诉求的高速市场,以往都要多通道控制器搭配四颗 FLASH 才能发挥速度,对于 UFD 斤斤计较的体积难以量产产品。银灿科技今日推出 IS902 搭配现有 2xnm/3xnm Flash 与新一代 DDR 接口可以轻易达到极速。以 3xnm SLC 为例,读取速度可达 130MB/s ,写入速度可达 130MB/s,效能凌驾市面上目前所有的四通道的 UFD 及 SSD 方案。

FLASH 效能方面

以 3xnm MLC L63B 32GB 为例,读取达 117MB/s,写入达 62MB/s。

Samsung 3xnm Toggle 读取 115MB/s, 2xnm MLC 以 L74A 为例亦可以达到读取 133MB/s,完全发挥 2xnm FLASH 更便宜的成本优势,可见银灿 IS902 双通道控制器效能及成本优势已经大幅超越目前其它四通道控制器的效能。

而 UFD 最在意的体积方面，IS902 USB 3.0 UFD 成品体积不论使用那一种 FLASH 都与 USB 2.0 UFD 相似甚至相同。就成本来看，目前 USB 2.0 UFD 与 USB 3.0 UFD 装机成本差异仅约 RMB10，更加速 USB 3.0 取代 USB 2.0 的时代来临。

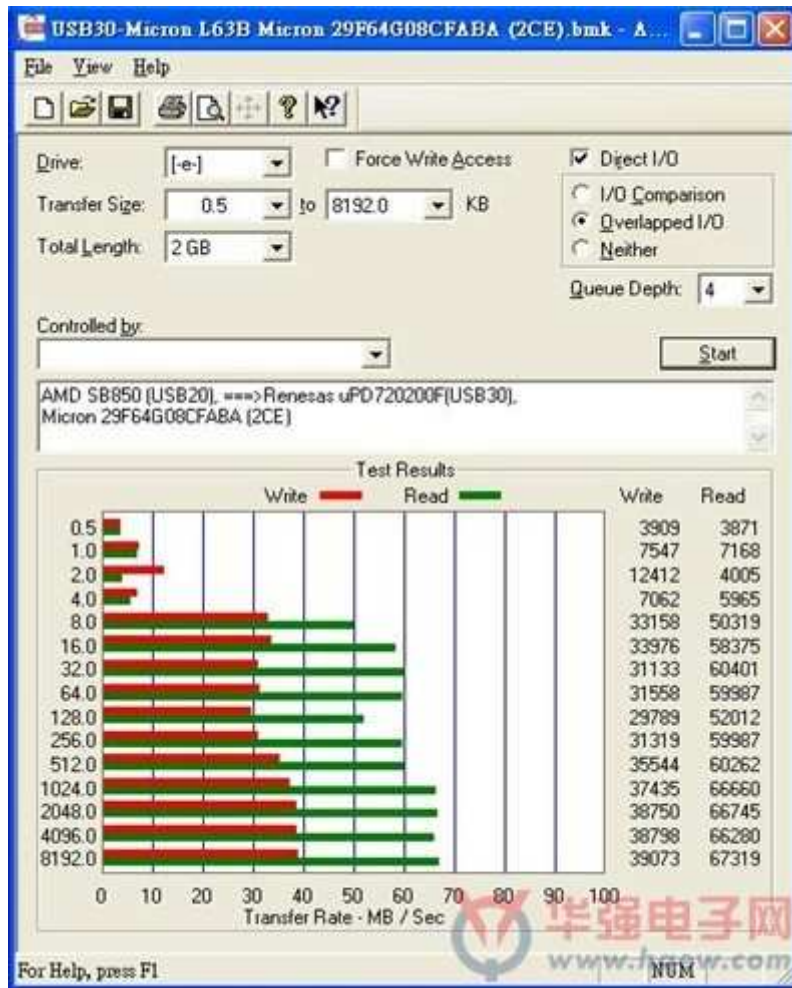
以 SLC 16GB U3 pen drive 为例，读写都可以大幅超越现有产品，甚至快过目前四通道的 USB SSD。



USB3.0 双通道 32GB MLC 性能



IS902 16GB U 盘 插入 USB2.0 接口的效能



现有的各种 Toggle/ONFI DDR FLASH 与 IS902 实机成品



极速的 IS902 16GB 体积



上图为内建 IS902 的 USB3.0 随身碟的应用设计范例及终端产品，依据各种 Flash 速度及容量不同，可以设计小巧但效能最大能达到写入 130MB 的产品。